



特点

1. 中心放大门极结构
2. 平板型陶瓷管壳封装
3. 低通态和开关损耗

典型应用

1. 逆变器	$I_{T(AV)}$	1000A
2. 斩波器	V_{DRM}/V_{RRM}	1600V
3. 感应加热	I_{TSM}	13KA
	I^2t	845 $10^3 A^2S$



主要参数

符号	参数	测试条件	结温	参数值			单位
			$T_J(^{\circ}C)$	最小	典型	最大	
$I_{T(AV)}$	通态平均电流	180°正弦半波, 50Hz 双面散热, $T_{hs}=106^{\circ}C$	125			1000	A
V_{DRM}	断态重复峰值电压	$V_{DRM} \& V_{RRM}$, $t_p=10ms$	125		1600		V
V_{RRM}	反向重复峰值电压	$V_{DSM} \& V_{RSM} = V_{DRM} \& V_{RRM} + 100V$	125		1600		V
I_{DRM}	断态重复峰值电流	$V_D = V_{DRM}$	125			60	mA
I_{RRM}	反向重复峰值电流	$V_R = V_{RRM}$	125			16	mA
I_{TSM}	通态不重复浪涌电流	10ms 底宽正弦半波	125			13	KA
I^2t	浪涌电流平方时间积	$V_R = 0.6 V_{RRM}$	125			845	$A^2s \cdot 10^3$
V_{TO}	门槛电压		125			0.93	V
r_T	斜率电阻		125			0.29	mΩ
V_{TM}	通态峰值电压	$I_{TM}=1500A$, $F=15kN$	125			1.80	V
dv/dt	断态电压临界上升率	$V_{DM}=67\% V_{DRM}$	125			1000	V/μs
di/dt	通态电流临界上升率	$V_{DM}=67\% V_{DRM}$ to 1000A 门极脉冲 $t_r \leq 0.5\mu s$ $I_{GM} = 1.5A$ 重复值	125			500	A/μs
I_{rm}	反向恢复电流	$I_{TM}=500A$, $t_p=1000\mu s$,	125			184	A
t_{rr}	反向恢复时间	$di/dt = -20A/\mu s$,	125			17.2	μs
Q_{rr}	恢复电荷	$V_R=50V$	125			1581	μC
I_{GT}	门极触发电流	$V_A=12V$, $I_A=1A$	25	35		300	mA
V_{GT}	门极触发电压	$V_A=12V$, $I_A=1A$	25	0.8		3.0	V
I_H	维持电流	$V_A=12V$, $I_A=1A$	25	20		250	mA
T_{stg}	存储温度	$V_A=12V$, $I_A=1A$		-40		140	°C

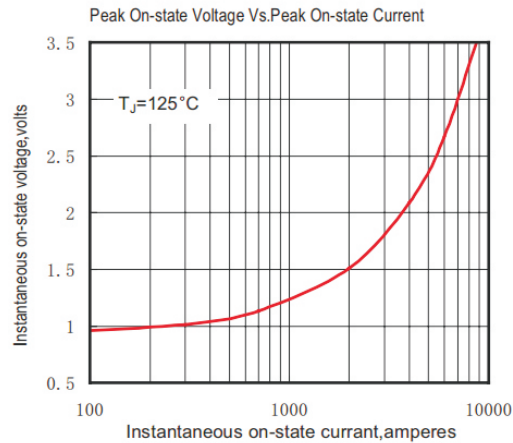


Fig.1

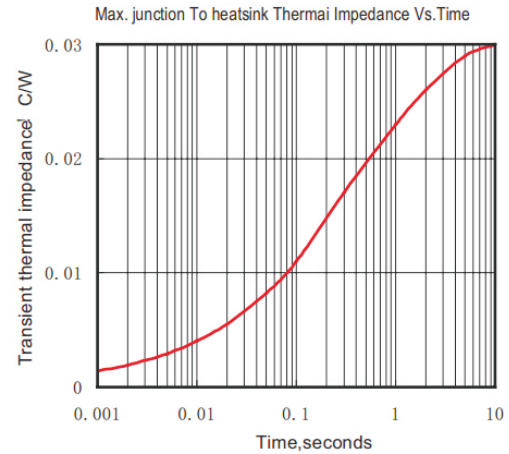


Fig.2

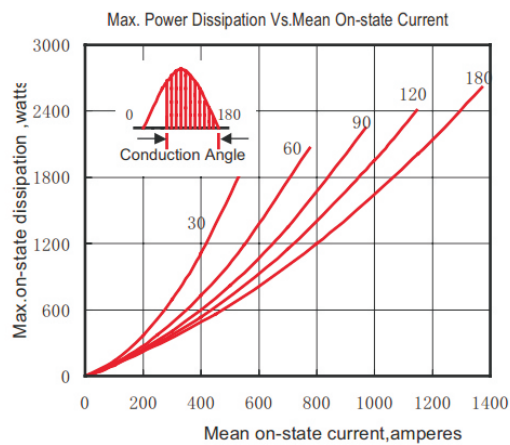


Fig.3

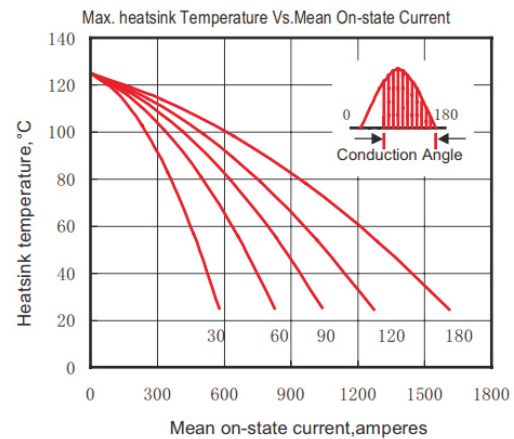


Fig.4

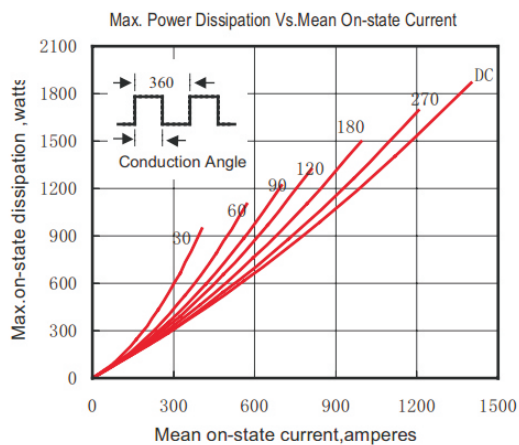


Fig.5

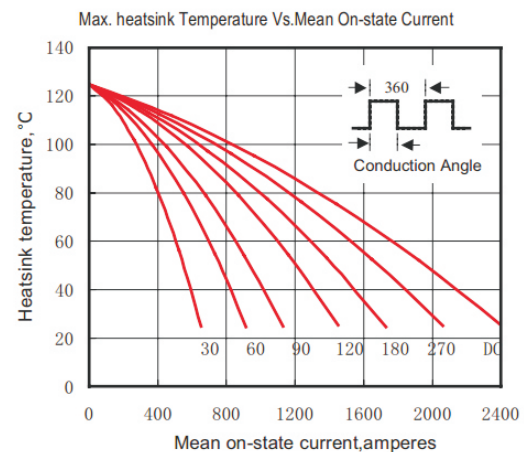


Fig.6

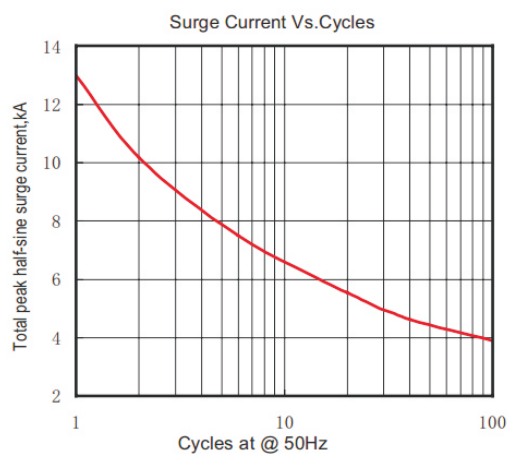


Fig.7

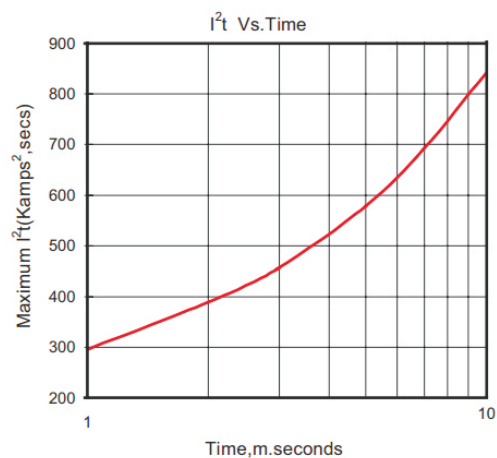


Fig.8

外形尺寸图

